

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Мурашев Виктор Николаевич
2	Дата рождения (полная)	24 июля 1947 года.
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (специальность 05.27.06)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по специальности 05.27.06
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119049, Москва, Ленинский пр-кт, 4 https://misis.ru/kancela@misis.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Высшее учебное заведение
	Наименование подразделения	Кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников
	Должность	профессор
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orlov O., Murashev V., Lebedev A., Orlov V., Ivanov S. Features of the improving of the HfO₂ ReRAM cells characteristics reproducibility // Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019. 8657230, с. 2087-2089 2. Krasnov A.A., Legotin S.A., Rabinovich O.I., Didenko S.I., Murashev V.N., Cheverikin V.V., Yakimov E.B., Starkov V.V., Fedulova N.A., Rogozev B.I., Laryushkin A.S. Development of betavoltaic cell technology production based on microchannel silicon and its electrical parameters evaluation // Applied Radiation and Isotopes. 2017. Т. 121. С. 71-75. 3. Нагорнов Ю.С., Мурашев В.Н. Моделирование бетавольтаического эффекта на кремниевых pin-структурах при облучении beta-источником никель-63 // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50. № 1. С. 17-22. 4. Yurchuk S.Y., Legotin S.A., Murashev V.N., Krasnov A.A., Omel'chenko Y.K., Osipov Y.V., Didenko S.I., Rabinovich O.I. Simulation the beta power sources characteristics // Журнал нано- и электронной физики. 2015. Т. 7. № 3. С. 03014. 5. Мурашев В.Н., Леготин С.А., Ельников Д.С., Кузьмина К.А. Быстродействующий приёмник оптических излучений // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2015. № 2-3 (236-237). С. 33-37. 6. Трошин С.В., Каргин Н.И., Харламов Н.А., Мурашев В.Н. Теоретическая оценка поверхностной проводимости диоксида титана при адсорбции кислорода // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2015. № 1 (157). С. 58-62. 7. Нагорнов Ю.С., Мурашев В.Н., Краснов А.А. Расчет токов генерации и эффективности структур бета-вольтаических элементов на основе источника 	

	никель-63 // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2015. № 3. С. 44-49.
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты